

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于收购上海芯石股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，本次交易尚未签署正式协议，协议具体条款包括交易对价、股份取得方式等尚需在中介机构尽调完成后进一步协商确定，本次交易的正式协议及最终实施还需经过深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）及上海芯石半导体股份有限公司（以下简称“上海芯石”或“标的公司”）各自的董事会、股东大会（如需）审批通过，因此本次交易实施时点及最终能否实施存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！

一、交易概述

2020年3月3日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署〈合作协议〉的议案》，为贯彻并实施公司向上游半导体纵向延伸的战略布局，公司与 Chang York Yuan（以下简称“张远”）、G Tech Systems Group Inc.,（以下简称“GTSGI”）签署《合作协议》，在半导体投资、研发设计、生产制造等方面进行深度合作，根据《合作协议》，公司应于英唐微技术有限公司（以下简称“英唐微技术”或“MTC”）股权收购交割日起30天内受让上海芯石10%-20%的股权，具体内容详见公司于2020年3月4日在巨潮资讯网上发布的《关于签署〈合作协议〉的公告》（公告编号：2020-020）。

二、最新进展

英唐微技术收购完成后，公司正在持续推进对英唐微技术现有的技术、产品及产线的深入了解、对接和融合，努力发挥和挖掘英唐微技术的潜能及其所处日本半导体产业核心区域的位置优势，为实施公司向上游半导体纵向延伸战略提供

有力的抓手，同时公司围绕 SiC 等第三代半导体器件产品持续开展产业布局，逐步实现从设计、制造到销售的全产业链条。其中 SiC 功率器件的生产制造能力正在通过对英唐微技术产品线的一部分改造来获得，而对 SiC 功率器件产品的设计研发能力，公司主要是依托于上海芯石在 SiC 领域的技术沉淀和人才储备。为更好地匹配公司的战略布局，实现公司与上海芯石利益的高度统一，并深度绑定上海芯石管理及技术团队。自公司收购完成英唐微技术后，公司与上海芯石控股股东北京吉泰科源科技有限公司（以下简称“吉泰科源”）、吉泰科源股东以及原《合作协议》各签署方一直就原参股上海芯石 10%-20% 股权的方案升级为收购其多数股权并实现控股的方案进行协商。截止本公告披露日各方已就控股方案达成初步意见并签订了《关于〈合作协议〉的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），主要内容如下：

甲方：深圳市英唐智能控制股份有限公司

乙方：

乙方一：施振飞，为乙方三股东

乙方二：张放歌，为乙方三股东

乙方三：北京吉泰科源科技有限公司，统一社会信用代码：
91110108766755108K

（乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”。）

丙方：

丙方一：Chang York Yuan，美国护照号码为 48817****

丙方二：G Tech Systems Group Inc.，公司注册号：C2147606

（丙方一、丙方二合称“丙方”。）

标的公司：上海芯石半导体股份有限公司，统一社会信用代码：
91310115MA1K3HKP1U

1. 甲方拟通过股权转让或增资的方式（以最终协议约定为准）取得标的公司 40% 股权并成为第一大股东（以下简称“本次交易”），最终交易价格将由交易各方参考具备证券从业资格的独立第三方机构估值报告协商确定。

2. 本次交易完成股权交割后甲方拟改组标的公司董事会，标的公司董事会由 5 名董事组成，甲方提名其中 3 名董事，甲方成为标的公司的控股股东；标的

公司财务负责人将由甲方委派专人担任,届时甲方将按照深圳证券交易所创业板上市公司的相关要求对标的公司财务进行规范管理。

3. 《合作协议》中曾约定甲方于完成对 MTC 股权收购交割日起 30 天内受让标的公司 10%-20%的股权,鉴于投资方案由参股标的公司变更为控股标的公司,各方同意本次交易实施期限变更为 MTC 股权收购交割日后 90 天内;在此期限内,各方经充分沟通协商后确定最终交易方案并签署正式的交易协议。

4. 本次交易的实施还应满足以下先决条件:

(1) 甲方及标的公司还需依法完成必要的董事会、股东大会(如需)审批程序;

(2) 甲方对标的公司完成尽职调查,并对尽职调查结果满意。

5. 本协议经各方签署盖章生效,并在以下日期终止(以较早到达日为准):

(1)本次交易的正式协议签署完成;

(2) 双方以书面方式或者实际行动表明不进行本次交易。

6. 本协议有效期内,在未取得甲方书面同意的情形下,乙方、丙方不得就标的公司引进新股东事宜与其他第三方接触。

7. 本协议任意一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失,各方另有约定的除外。

8. 本协议仅为表示各方关于本次交易的意向,具体交易条件及其他交易细节以甲方与乙方及标的公司最终签署的正式协议为准。

截止本公告披露日,公司聘请的各中介机构已进场对上海芯石展开尽职调查,待尽职调查完成并由独立第三方机构出具估值报告后,相关各方将协商确定最终的交易对价及交易方案,本次交易的正式协议及最终实施尚需经过公司及上海芯石各自的董事会、股东大会(如需)审批通过。

三、本次交易对公司的影响

公司完成对英唐微技术 100%股权收购的交割工作后,正在持续推进对英唐微技术现有的技术、产品及产线的深入了解、对接和融合,努力发挥和挖掘英唐微技术的潜能及其所处日本半导体产业核心区域的位置优势,为实施公司向上游半导体纵向延伸战略提供有力的抓手。公司围绕第三代半导体器件产品持续开展

产业布局，将逐步实现从设计、制造到销售的全产业链条。在生产制造方面，公司正在对英唐微技术现有生产线进行部分改造，在第一阶段改造完成后，公司将拥有完全自主的第三代半导体 SiC 功率器件的生产能力。但公司在 SiC 功率器件领域的研发力量目前还是主要依托原来拟参股的上海芯石、已经收购的英唐微技术的研发团队和技术储备。

其中上海芯石以其子公司上海芯石微电子有限公司为基础，在半导体件芯片尤其是肖特基二极管芯片(SBD)领域已经具有了十几年的技术储备及行业经验，业务产品主要覆盖两大类：**Si 类**（SBD、FRED、MOSFET、IGBT、ESD 等功率芯片产品）、**SiC 类**：（SiC-SBD、SiC-MOSFET）。分别形成了与产品性能密切相关的 IP 共计 63 项，其中 SiC 产品领域目前形成了 2 项实用新型专利、2 项集成电路布图，1 项发明专利（实审），具体情况如下：

IP 名称	发布号	类型	状态
一种具有复合沟槽结构的碳化硅肖特基器件及其制造方法	201811560544.8	发明	实审
一种具有复合沟槽结构的碳化硅肖特基器件	201822141424.6	实用新型	授权
一种耐用的碳化硅肖特基二极管	201920378123.7	实用新型	授权
三相全桥 SiCMOS 驱动芯片	BS.205545882	集成电路布图	授权
双相全桥 SiCMOS 驱动芯片	BS.205545890	集成电路布图	授权

在三代半导体 SiC-SBD 器件领域，上海芯石已经成功开发了 600V、1200V、1700V、3300V 产品，而当前市场主流产品集中在 1700V 以下，超过 1700V 的本土高压高频高功率器件并不多见。上海芯石已经通过代工厂实现了部分 SiC 型号产品的小批量量产并形成销售收入，其未来 SiC 器件流片、大批量制造工作可直接由产线改造升级完成后的英唐微技术进行承接，实现公司设计、制造业务的高效对接。同时，公司拟以上海芯石为平台，持续吸收国内在半导体芯片，尤其是第三代半导体领域的优秀技术人才和团队，不断提升和丰富公司在上述领域的产品设计研发能力。

因此上海芯石的技术储备和行业经验是继英唐微技术后，公司逐步完善半导体芯片，特别是第三代半导体设计、制造及销售全产业链条的重要抓手，对其收购控股，将可以极大的保障上海芯石在第三代半导体领域的技术、行业优势全面快速的转化为公司自身优势，并最大限度的服务于公司整体战略目标的实现。

四、风险提示

1.截至本公告披露日，本次交易尚未签署正式协议，协议具体条款包括交易对价、股份取得方式等尚需在中介机构尽调完成后进一步协商确定，本次交易的正式协议及最终实施尚需经过公司及上海芯石各自的董事会、股东大会（如需）审批通过，因此本次交易实施时点及最终能否实施存在不确定性。

2.公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1.《关于<合作协议>的补充协议》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年11月16日